

ПРОГРАММА

Школы молодых ученых

«Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем»

29–30 ноября 2023 г.

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13, конференц-зал (3 этаж)

Среда, 29 ноября

8:30 – 9:00	Регистрация участников Школы		
9:00 – 9:15	Открытие		
9:15 – 10:00	<u>Щеглов Дмитрий Владимирович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Кремниевые меры высоты от микрона до пикометра
10:00 – 10:45	<u>Смагина Жанна Викторовна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Методы получения и оптические свойства фотонно-кристаллических структур со встроенными в них массивами упорядоченных GeSi квантовых точек
10:45 – 11:00	Перерыв, кофе-брейк		
11:00 – 11:45	<u>Володин Владимир Алексеевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Комбинационное рассеяние света для исследования наноструктур
11:45 – 12:30	<u>Гейдт Павел Викторович</u>	НГУ, г. Новосибирск	Современные методики сканирующей зондовой микроскопии для полупроводниковых наноматериалов
12:30 – 13:15	<u>Вайнер Борис Григорьевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Инфракрасная термография как макрометод исследования твердотельных наносистем
13:15 – 14:00	<u>Обед</u>		
14:00 – 18:00	Представление стендов участниками Школы		
	Перерыв, кофе-брейк		
	Стендовая сессия		

Четверг, 30 ноября

9:00 – 9:45	<u>Рогило Дмитрий Игоревич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Углеродные нанотрубки для приёмников терагерцового излучения
9:45 – 10:30	<u>Антонова Ирина Вениаминовна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	2D печатные технологии на основе графена для устройств гибкой наноэлектроники
10:30 – 11:15	<u>Селезнев Владимир Александрович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Природоподобные наноматериалы и наноструктуры: технологии изготовления, практические применения
11:15 – 11:30	Перерыв, кофе-брейк		
11:30 – 12:15	<u>Шамирзаев Тимур Сезгирович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Спиновая поляризация в немагнитных полупроводниковых наноструктурах
12:15 – 13:00	<u>Альперович Виталий Львович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Фотоэффекты в полупроводниковых наноструктурах
13:00 – 14:00	Обед		
14:00 – 14:45	<u>Асеев Александр Леонидович</u>	НГУ, г. Новосибирск	Полупроводники и нанотехнологии
14:45 – 15:30	<u>Голяшов Владимир Андреевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Фотоэлектронная спектроскопия: от простого элементного анализа до изучения электронной структуры поверхности твердых тел
15:30 – 16:00	<u>José Coutinho</u>	i3N and Department of Physics University of Aveiro, Portugal	The what's and how's of defects in Si-based solar cell (with and introduction to density functional theory) (in english, on-line)
16:15 – 16:30	Вручение дипломов. Закрытие Школы		



Стендовая сессия, 29 ноября, 14:00 – 18:00, холл перед конференц-залом

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
1	Бузмакова Анна Андреевна	Новосибирский государственный технический университет	Сенсоры из композитных слоёв на основе графена и проводящего полимера PEDOT:PSS
2	Дирко Владимир Владиславович	Томский государственный университет	Исследование эпитаксиального роста Si на Si(001) по особенностям картин дифракции ДБОЭ
3	Егоров Дмитрий Александрович	Новосибирский государственный университет	Измерения длины электрон-электронного рассеяния в подвешенных микроструктурах методом магнитной фокусировки
4	Захожев Константин Евгеньевич	Новосибирский государственный университет	Рост SnSe ₂ , инициированный кристаллизацией тонкого аморфного слоя на поверхностях Bi ₂ Se ₃ (0001) и Si(111)
5	Капогузов Кирилл Евгеньевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Многоуровневые резистивные переключатели на основе диоксида ванадия с фазовым переходом полупроводник-металл
6	Кислухин Никита Александрович	Новосибирский государственный технический университет	Исследование кинетики реакции диспропорционирования тонких пленок GeO оптическими методами
7	Кукенов Олжас Игоревич	Томский государственный университет	Динамика длины димерного ряда сверхструктуры 2xN в процессе эпитаксиального роста Ge/Si(100) в широком температурном диапазоне
8	Майдэбура Ян Евгеньевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Капельная эпитаксия квантовых точек GaN на поверхности Ван-дер-Ваальсовой структуры g-SiN
9	Манцуров Никита Дмитриевич	Новосибирский государственный технический университет	Создание массивов иерархических наноструктур VO ₂ с помощью сканирующей зондовой литографии
10	Манцунова Снежана Викторовна	Новосибирский государственный технический университет	Монте-Карло моделирование движения капель Au-Si по поверхности кремния с ориентацией (011)
11	Махмудиан Мехрдад Махмудович	Новосибирский государственный университет	Перколяционная теория классического неидеального двумерного электронного газа в сильных магнитных полях

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
12	Меркулин Кирилл Витальевич	Новосибирский государственный технический университет	Влияние морфологии поверхности GaAs(111)A на скорость движения капель галлия при ленгмюровском испарении (Монте-Карло моделирование)
13	Миллюшин Дмитрий Максимович	Новосибирский государственный университет	Резистивные переключения в микроструктурах на основе диоксида ванадия с фазовым переходом полупроводник-металл
14	Миронов Никита Алесеевич	Новосибирский государственный университет	Исследование электромагнитного отклика динамически перестраиваемых гибридных метаматериалов на основе диоксида ванадия
15	Непомнящих Вячеслав Алексеевич	Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН	Состав и структура тонких пленок аморфного нестехиометрического оксида кремния
16	Никифоров Данил Фёдорович	Новосибирский государственный университет	Влияние высокотемпературного резистивного нагрева на проводимость подложек SiC
17	Парамонова Мария Алексеевна	Новосибирский государственный университет	Влияние отжига на параметры Pt/InAlAs барьеров Шоттки
18	Пономарев Сергей Артемьевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Высокотемпературная адсорбция индия на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ в колонне <i>in situ</i> отражательного электронного микроскопа
19	Рябов Виталий Олегович	Новосибирский государственный университет	Молекулярно-динамическое моделирование CVD синтеза графена при различных температурах
20	Суханов Максим Андреевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Датчик магнитного поля на основе InSb
21	Хорошилов Владимир Сергеевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Измерение фотоэдс на поверхности <i>p</i> -GaAs(Cs) методами фотоотражения и фотоэмиссии